



**SOT-23 Plastic-Encapsulate Transistors**

AAAAAAA  
**13001 NPN 功率三极管**

**\* 主要用途:**

电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

**\* 主要特点:**

硅三重扩散平面工艺、输出特性好、电流容量大。

\*'' : 5@5%

**极限值: (Tc=25 °C)**



参 数 名 称	符 号	额 定 值	单 位
集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$\geq 400$	V
集电极-基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$\geq 700$	V
发射极-基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$\geq 9$	V
最大集电极直流电流	$I_{cm}$	0.5	A
最大耗散功率	$P_{cm}$	10	W
最高结温	$T_{jm}$	150	°C
贮存温度	$T_{stg}$	- 55 ~ 150	°C

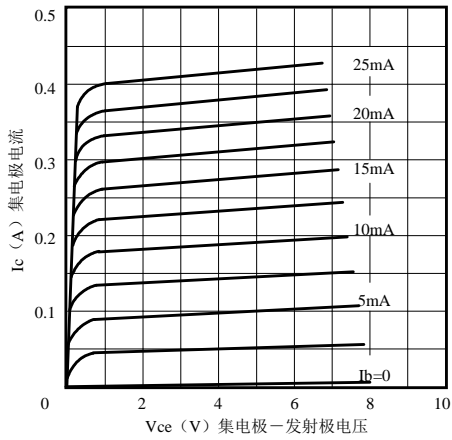
**电特性: (Tc=25 °C)**

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值		单 位
			最 小 值	最 大 值	
集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=1mA; I_B=0$	400		V
集电极-基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_C=1mA; I_E=0$	700		V
发射极-基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E=1mA; I_C=0$	9		V
集电极-发射极反向漏电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=380V; I_B=0$		20	uA
集电极-基极反向漏电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=680V; I_E=0$		10	uA
发射极-基极反向漏电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=7V; I_C=0$		10	uA
共发射极直流电流增益	$H_{FE}$	$V_{CE}=5V; I_C=50mA$	15	35	
		$V_{CE}=5V; I_C=1mA$	8		
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=0.2A; I_B=0.1A$		0.6	V
特征频率	fT	$V_{CE}=10V; I_C=0.1A; f=1MHz$	8		MHz
存储时间	$T_s$	UI9600; $I_C=100mA; I_B=1mA$	1.5	2.0	uS

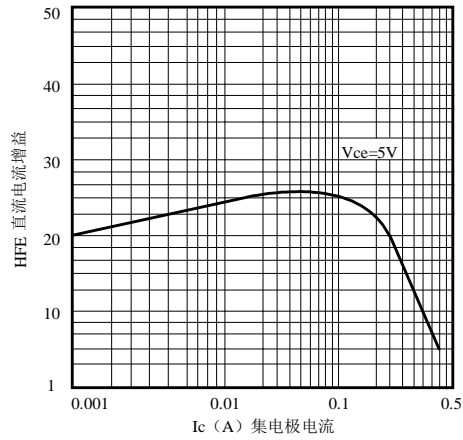
**CLASSIFICATION OF  $h_{FE(1)}$**

Range	10-13	13-16	15-18	18-21	20-25	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

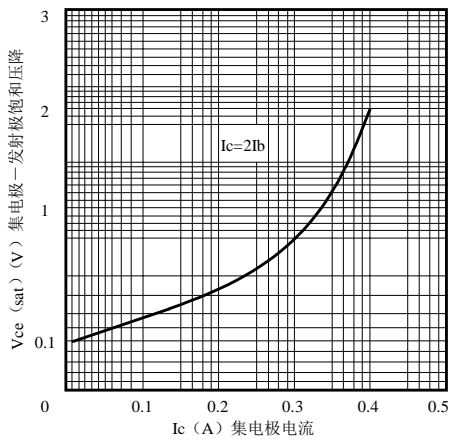
静态输出特性



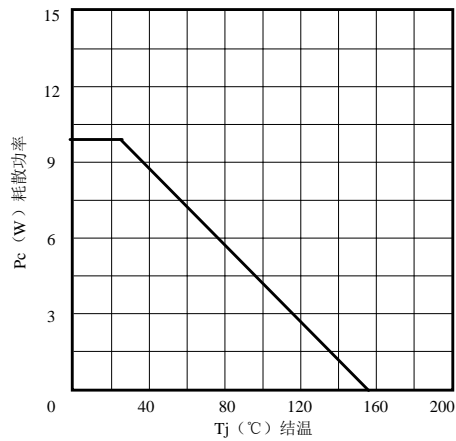
HFE 直流电流增益 -  $I_c$  集电极电流



$V_{ce(sat)}$  集电极-发射极饱和电压 -  $I_c$  集电极电流



$P_c$  耗散功率 -  $T_j$  结温



SOA (DC) 安全工作区

